



PCle M.2 SSDs

# MTE662P & MTE662P-I

創見MTE662P固態硬碟搭載PCIe Gen 3 x4介面,符合最新NVMe 1.3規範,帶來前所未有的傳輸效能;採用最新一代 3D NAND技術,可堆疊高達96層快閃記憶體,相較於前一代3D NAND的64層堆疊,大幅突破單位密度上限,達到更高 的儲存效益。創見MTE662P固態硬碟內建DRAM快取記憶體,提供絕佳的隨機存取速度,同時經過嚴格的廠內測試, 達到3K抹寫次數的耐用度等級。 MTE662P搭載30µ"金手指厚金鍍層PCB及邊緣補強(Corner Bond)技術,提供優異可 靠的性能,更結合智慧電源保護(IPS)功能,確保資料完整性。此外,MTE662P具備類寬溫特性(-20°C~75°C),完 美滿足任務密集型應用的需求。

創見亦推出具備寬溫特性的MTE662P-I固態硬碟,可於-40°C到85°C下穩定運作,以確保工業機台於任務密集型應用中 穩定運作,實現卓越的運作效能、最佳的耐用度以及可靠性。

#### 硬體特點

- 30µ"金手指厚鍍金工藝
- 內建DDR4 DRAM快取記憶體
- 智慧電源保護(IPS)功能,避免因意外斷電而丟失資料
- 全系列產品搭載邊緣補強技術(Corner Bond), 保護關鍵元件
- 包含類寬溫(-20°C~75°C)與寬溫(-40°C~85°C)規格,適合極端工控操作 環境

### 韌體特點

- 支援全區平均抹寫及故障區塊管理,增加可靠度
- 支援NVM指令
- 內建LDPC ECC自動糾錯功能
- 動態熱能管理機制
- 內建SLC caching技術

#### 訂購資訊

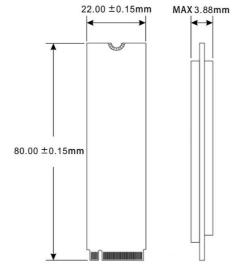
128GB	TS128GMTE662P	
256GB	TS256GMTE662P TS256GMTE662P-I	
512GB	TS512GMTE662P TS512GMTE662P-I	
1TB	TS1TMTE662P TS1TMTE662P-I	



## 規格

外觀	尺寸	80 mm x 22 mm x 3.88 mm (3.15" x 0.87" x 0.15")
	重量	9 g (0.32 oz)
	外觀尺寸	M.2
	M.2規格	2280-D2-M (雙面打件)
介面	匯流排介面	NVMe PCle Gen3 x4
存儲	Flash類型	3D快閃記憶體
	容量	128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
操作環境	工作電壓	3.3V±5%
	工作溫度	類寬溫 -20°C (-4°F) ~ 75°C (167°F) 寬溫 -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F)
	儲存溫度	-55°C (-67°F) ~ 85°C (185°F)
	濕度	5% ~ 95%
	耐衝擊	1500 G, 0.5 ms, 3 axis
	耐振動 (操作中)	20 G (peak-to-peak), 7 Hz ~ 2000 Hz (frequency)
電量	耗電量 (操作中)	3.4 瓦
	耗電量 ((IDLE)	1.0 瓦
效能	連續讀寫速度 (CrystalDiskMark)	讀取: 高達 3,400 MB/s 寫入: 高達 2,300 MB/s
	4K隨機讀寫速度 (IOmeter)	讀取: 高達 340,000 IOPS 寫入: 高達 355,000 IOPS
	平均故障間隔 (MTBF)	3,000,000 小時
	寫入兆位元組 (TBW)	高達 2,200 TBW
	每日全碟寫入次數 (DWPD)	2 (3 年)
保固	安規認證	CE / FCC / BSMI
	保固	三年有限保固

### 機構尺寸



產品規格如有變更,恕不另行通知。外觀圖片僅供參考,請以實際產品為準。總可用容量會因操作環境而異。由於工業應用的多元性及複雜性,創見無法保證本產品完全相容於所有平台與使用情境。如有特殊需求及操作環境,建議您購買前先與我們聯繫。